

# 超低功耗 LDO 线性稳压器

上海英联电子科技有限公司 杨永华 徐宁

#### 一、前言

在智能终端高速发展的今天,如何延长电池的使用寿命就成为了电子设计人员的重要课题。目前市面上的 MCU 等处理器处于休眠模式时,功耗可以达到 1uA 以内。由于设备大部分时间处于休眠状态,因此线性稳压器 LDO 的静态工作电流就决定了电池的使用寿命。

上海英联电子推出了 UM153XX、UM154XX 系列超低静态工作电流的 LD0, 其典型值仅有 1.2uA (Vin=5V)。适用于穿戴式产品、便携式产品以及需要备份电池供电的设备,可以有效延长电池使用寿命。

#### 二、UM153XX、UM154XX 的重要参数

英联的 UM153XX、154XX 系列是超低静态工作电流的电压稳压器(其原理框图见图 1),可使用 1μF以上的陶瓷电容器作为输出电容。输入电压范围: 2. 2V~5. 5V,输出电压范围为 1. 3V~5V。

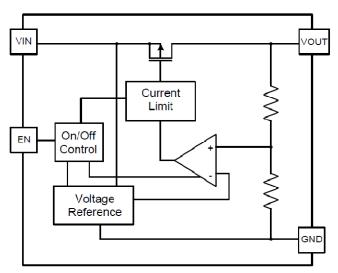


图 1 超低静态工作电流 LDO 的原理框图

UM153XX 系列提供两种封装供客户选择,SOT23-3、SOT89-3,与市面同类型芯片兼容。UM154XX 系列带有使能管脚,封装为 SOT23-5。,其主要参数如表 1 所示:

Symbol	Parameter	Test conditions	Min	Тур	Max	Unit
VIN	Input Voltage Range		2. 2		5. 5	V
Vout	Output Voltage Range		1.3		5. 0	V
IQ	Quiescent Current	IOUT=0mA,VIN=5.0V		1.2	3	μА
△Vоит	Load Regulation	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +1V(V <sub>IN</sub> ≥3V), 1mA≤I <sub>OUT</sub> ≤100mA		10		mV
IENH	Enable High Current	V <sub>EN</sub> =5.5V			1	μА
IENL	Enable Low Current	V <sub>EN</sub> =0V			1	μА
Іоит	Output Current	V <sub>IN</sub> ≥3V	100			mA
		V <sub>IN</sub> ≥3.5V	200			mA
Ilimt	Current Limit			300		mA

表 1 特性参数表

<sup>1、</sup>静态电流 Iq



静态电流为输出电流与输如电流的差,LD0的效率与输入、输出电压和静态工作电流有关。 效率可由以下公式算出:

效率= 
$$\frac{\text{Vo} \times \text{Io}}{(\text{Io} + \text{Ig}) \times \text{Vin}} \times 100\%$$

由公式可看出,当 LDO 处于轻负载情况下,静态电流就显得尤为重要, Iq 值越小,效率越高。图 2 为 UM153XX 系列 LDO 的 Iq 值在不同输入电压情况下与同类低功耗 LDO 的对比,由图 2 可看出,UM153XX 在低压供电情况下,有明显的优势。

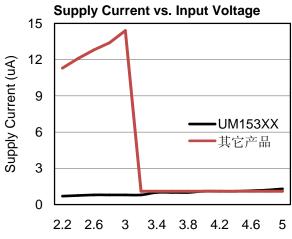


图 2 静态工作电流随输入电压变化图

#### 2、动态负载调整(△VOUT)

当输入电压一定时,输出电压随负载电流的变化而产生的变化量。只要负载电流变化缓慢,大多数 LDO 都能轻松地保持输出电压接近恒定不变。然而,当负载电流快速改变时,输出电压也将随之改变。当负载电流发生变化时,输出电压的改变量决定负载瞬态性能。当负载电流由1mA 瞬时变为 100mA 时,UM153XX 系列 LDO 的输出电压变化量仅为 10mV。

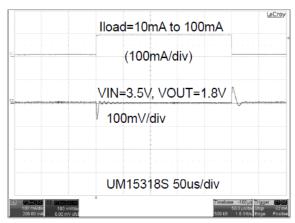


图 3 负载瞬态响应

## 3、压差 (△VDO)

压差可表示为Vdrop,是指保持电压稳定所需的输入电压与输出电压之间的最小差值。当输入电压下降到一定程度时,输出电压将不能维持在一恒定值。其具体算法如下:

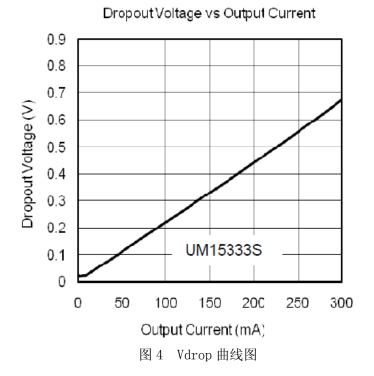
输入电压为VIN = VOUT(s) + 1.0 V时的输出电压值为VOUT3,缓慢降低输入电压(VIN),当输出电压降至为VOUT3的98%时,此时的输入电压(VIN1)与输出电压的差即为输入输出电压差:  $Vdrop = VIN1 - (VOUT3 \times 0.98)$ 

压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高。负载电流和结点温度会影响这个压差。最大

2/4



压差值应在整个工作温度范围和负载电流条件下加以规定。在非调整区域,Vdrop的值呈线性变化,图4为UM15333的压差随输出电流变化的曲线图。



# 4、过载电流保护

UM153XX系列LD0为了保护输出晶体管免受过大的输出电流,以及VOUT管脚—GND管脚之间短路的影响,内置了过载电流保护电路。最大限流300mA,负载电流小于限流时,输出电压即可恢复为正常值。

三、应用注意事项:

#### 1、电容的选择:

输出电容及其等效串联电阻 ESR,将影响环路稳定性和对负载电流瞬态变化的响应性能。为了确保输出的稳定性,如果使用  $1\mu$ F 输出电容,请尽量选用 ESR 值为  $0.3\Omega$  或以下的,推荐 X7R 或 X5R 陶瓷电容。另外,LDO 要求使用输入和输出电容来滤除噪声和控制负载瞬态变化,输入电容器因应用电路的不同所需要的容值也不同。电容值越大,LDO 的瞬态响应性能越好,缺点是会延长启动时间。在电源的阻抗偏高的情况下,当 IC 的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,请加以注意。

## 2、封装的选择:

SOT23-3 的最大额定功率为 0.4W, SOT89-3 的最大额定功率为 1W, SOT23-5 的最大额定功率 为 0.6W。请注意输入、输出电压以及负载电流的使用条件,避免 IC 内的功耗超过封装的容许功耗。

### 3、PCB 布线:

重点要考虑噪声、纹波和散热问题,尽可能将输出电容(CL)接在 VOUT-VSS 管脚的附近,将输入电容(CIN)接在 VIN-VSS 管脚的附近,LDO 和电容要使用同一铜层铺地,尽量增加地面积。



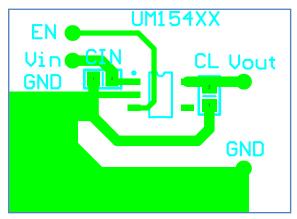
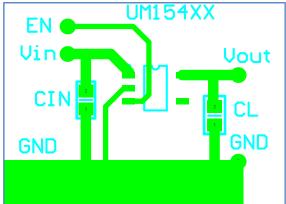


图 3



推荐 Layout

PCB 布线设计

不推荐的 Layout